DESIGN OF THE SIX-ELECTRODE CIRCULAR CROSS-SECTIONAL BPM FOR SECOND-ORDER MOMENT MEASUREMENT

Kenichi Yanagida*, Shinsuke Suzuki and Hirofumi Hanaki, JASRI, Accelerator Division /SPring-8 1-1-1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679-5198

Abstract

A six-electrode circular cross-sectional beam position monitor (BPM) was designed for a second-order moment measurement. A type of electrode is stripline which is similar to that of the existing BPM in the SPring-8 linear accelerator. Because of saving a number of detection circuits a number of electrodes was decided as six which is the smallest number for a second-order moment measurement. Because a stripline electrode composes a transverse electromagnetic mode transmission line its characteristic impedance can be solved by means of calculating an electrostatic capacitance per unit length. An electrostatic capacitance per unit length can be obtained using an approximation of parallel plate capacitor. For more accuracy the numerical calculation using a finite difference method was developed. The accuracy of numerical calculation is estimated about 1 %.

二次モーメント測定用六電極円形断面 BPM の設計

1. はじめに

現在、多くの加速器施設でビーム位置モニタ(BPM) が使用されており、ビーム重心位置の測定に使用されて いる。近年はビーム重心位置のみならず、ビーム広がり (二次または三次モーメント)を測定するために、八つ の電極やピックアップを有する円形断面の BPM が開発 され、使用されている^{[1][2]}。

SPring-8 線型加速器では非分散部及び分散部に於い て、ビーム広がり(二次モーメント)の観測を可能とす る六電極 BPM を設置する予定である。非分散部に於い てビーム広がりを観測する目的は、Twiss パラメータを 測定するためであり^[3]、分散部に於いてはエネルギー 広がり($\Delta E/E$)を測定するためである。

横方向二次元平面内の電荷分布に於いて、独立なn次 モーメントは二つ存在し、それらを AP_n 及び AQ_n と する(Λ は単位長さ当たりの電荷量)。 AP_n 及び AQ_n はn次モーメントのサイズ a_n と仰角 α_n を用いて、

$$\begin{aligned}
\Lambda P_n &= \Lambda a_n^n \cos n\alpha_n \\
\Lambda Q_n &= \Lambda a_n^n \sin n\alpha_n \\
(0 &\le a_n, 0 &\le n\alpha_n < 2\pi)
\end{aligned} \tag{1}$$

と表わされる。座標の原点は円形断面真空ダクトの中心 である。

実際にビームを測定して得られる物理量は各次モーメントを単位長さ当たりの電荷量で除した量 *P_n* 及び *Q_n*であり、一次及び二次のそれらは以下の通りである。

$$P_1 = a_1 \cos \alpha_1$$

$$Q_1 = a_1 \sin \alpha_1$$
(2)

$$P_2 = a_2^2 \cos 2\alpha_2$$

$$Q_2 = a_2^2 \sin 2\alpha_2$$
(3)

* ken@spring8.or.jp

 P_2 及び Q_2 は真空ダクト中心を原点としたものであるが、我々が本質的に知りたいのはビーム広がりに関する量、すなわち、ビーム重心を原点とした二次モーメントを電荷量で除した量 P_{g2} 及び Q_{g2} である。 P_{g2} 及び Q_{g2} は以下の関係式から得られる。

$$P_{2} = a_{1}^{2} \cos 2\alpha_{1} + P_{g2}$$

$$Q_{2} = a_{1}^{2} \sin 2\alpha_{1} + Q_{g2}$$
(4)

 P_{g2} 及び Q_{g2} には式(3)のような関係を満たすサイズ a_{g2} と仰角 α_{g2} が存在する。

$$P_{g2} = a_{g2}^2 \cos 2\alpha_{g2} Q_{g2} = a_{g2}^2 \sin 2\alpha_{g2}$$
(5)

 a_{g2} 及び α_{g2} はビーム電荷分布が楕円形状の場合に、図 1 に示されるようなサイズと仰角を表すパラメータとなる。二次モーメントサイズの二乗 a_{g2}^2 は、楕円形状に於ける長径方向のサイズを σ_u 、短径方向のサイズを σ_v とした場合に以下の関係となる(図 1 参照)。

$$a_{g2}^2 \sim \sigma_u^2 - \sigma_v^2 \tag{6}$$

通常の加速器に於いては、スキュー四極磁場が存在しない場合が多い。この場合は $\alpha_{g2} = 0, \pi/2$ となるので、 P_{g2}及び Q_{g2} は、

$$P_{g2} = a_{g2}^2, -a_{g2}^2$$

$$Q_{g2} = 0$$
(7)

と単純な形となる。 $\alpha_{g2} = 0$ の場合は楕円の長径方向が x 方向、短径方向がy 方向となり、 $\alpha_{g2} = \pi/2$ の場合は 長径方向がy 方向、短径方向がx 方向となる。いずれ の場合でも式(7)は、

$$P_{g2} \sim \sigma_x^2 - \sigma_y^2$$

$$Q_{g2} = 0$$
(8)



図 1: ビーム電荷分布が楕円形状の場合の a_{g2} 、 α_{g2} と σ_u 、 σ_v の関係図(電荷密度を等高線で表している)

で表される。

ビーム電荷分布によって半径 *R* の円形断面金属ダクト内面に発生する電場の大きさ *E*(*R*, *θ*) は

$$E(R,\theta) = \frac{\Lambda}{2\pi R\varepsilon_0} \left\{ 1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{O_n(\theta)}{R^n} \right\}$$

$$O_n(\theta) = P_n \cos n\theta + Q_n \sin n\theta$$

$$= a_n^n \cos n(\theta - \alpha_n)$$
(9)

と表される。ここで、 $O_n(\theta)$ は変調関数であり、 P_n 及び Q_n はダクト内面電場分布の $\cos n\theta$ 及び $\sin n\theta$ 成分の係数となって現れている。これは電場の角度分布を 測定することで、係数 P_n 及び Q_n が得られる事を意味する。

BPM は一般的には、金属ダクト内にストリップライン電極やボタン電極を配している。複数の電極が存在する場合が一般的である。ここでは *i* 番目の電極に於ける出力電圧 *V_i* は電極面での電場積分値に比例すると仮定する。

$$V_i \propto \int_{R,i} E(R,\theta) d\theta$$
 (10)

SPring-8 線型加速器では上に示す式 (9) 及び (10) を使 用して、図 2 及び図 3 に示すような P₂ 及び Q₂ が測定 可能な円形断面 BPM の設計・製作を行った。本件はそ の設計に関しての発表である。

2. 電極占有角と出力差分

2.1 電極占有角

二次モーメントまで測定する場合、独立変数は式(9) より、 Λ 、 P_1 、 Q_1 、 P_2 及び Q_2 の5つであり、最低必要な電極数は5である。しかし、今後の扁平ダクト等への拡張を考慮した場合、主に上下の対称性が必要となるので電極数は6とした。

SPring-8 線型加速器に於いて、現在使用されている 四電極円形断面 BPM の電極占有角は $5\pi/18$ (50°)で ある。六電極の場合、製作上の幾何条件及び出力電圧 差分の条件から電極占有角を $\pi/6$ (30°)とした(図 4 参照)。



図 2: 設計・製作された六電極円形断面 BPM (写真)



図 3: 設計・製作された六電極円形断面 BPM (図面)

電極形状は四電極円形断面 BPM と同じくストリップ ライン形状で、特性インピーダンスが約50Ωとなるよ うにした。ストリップライン伝送路の端にはフィードス ルーが取り付けられ、50Ω同軸ケーブルを介して信号 処理回路へ電極出力電圧が送られる。ストリップライン 伝送路の他端は0Ωで終端した形状となっている(図2 及び図3参照)。



図 4: 六電極円形断面 BPM の断面図

2.2 電極出力電圧差分定義

各電極からの出力電圧の差分 C_n 及び S_n を定義する。 二次モーメントまで測定するので、n = 1,2となる。 C_n 及び S_n の選び方は一意ではないが、測定精度が最も良

くなるよう、以下のように差分を定義した。

$$C_{1} = \frac{V_{1} - V_{3} - V_{4} + V_{6}}{V_{1} + V_{3} + V_{4} + V_{6}}$$

$$S_{1} = \frac{V_{2} - V_{5}}{V_{2} + V_{5}}$$

$$C_{2} = \frac{V_{1} + V_{3} + V_{4} + V_{6} - 2(V_{2} + V_{5})}{V_{1} + V_{3} + V_{4} + V_{6} + 2(V_{2} + V_{5})}$$

$$S_{2} = \frac{V_{1} - V_{3} + V_{4} - V_{6}}{V_{1} + V_{3} + V_{4} + V_{6}}$$
(11)

式 (9), (10) 及び (11) から、以下のような C_1 、 S_1 、 C_2 、 $S_2 \ge P_1$ 、 Q_1 、 P_2 、 Q_2 の関係式が得られる。

$$P_{1} \approx 9.346 \times 10^{-3}C_{1}$$

$$Q_{1} = 8.093 \times 10^{-3}S_{1}$$

$$P_{2} \approx 13.37^{2} \times 10^{-6}C_{2}$$

$$Q_{2} \approx 12.44^{2} \times 10^{-6}S_{2}$$
(12)

両辺の単位系は n = 1 の場合が [m]、n = 2 の場合が [m²] である。

SPring-8 線型加速器に於いて現存の信号処理回路を使用した場合、電極出力電圧差分の測定精度は 1×10^{-3} 程度と見積もられる^[4]。この測定精度を式(12)の C_n 及び S_n に代入すると、測定可能な P_n 及び Q_n の大きさが求まる。それらは $P_1 \approx 9.346 \times 10^{-6}$ 、 $Q_1 = 8.093 \times 10^{-6}$ 、 $P_2 \approx 13.37^2 \times 10^{-9}$ 及び $Q_2 \approx 12.44^2 \times 10^{-9}$ である。 P_2 及び Q_2 は二次なので、その大きさ(広がり)を把握するために平方根を取る。すなわち、 $\sqrt{P_2} \approx 422.8 \times 10^{-6}$ 、 $\sqrt{Q_2} \approx 393.3 \times 10^{-6}$ である。以上から、現存の信号処理回路を使用した場合、ビーム重心位置の情報として $10 \ \mu m$ 程度、ビーム広がりの情報として $400 \ \mu m$ 程度が測定限界であると判断できる。

現在 SPring-8 線型加速器では電極出力電圧差分の測定 精度が 1×10⁻⁴ 程度となるような低ノイズ信号処理回路 を開発している。もし、この低ノイズ信号処理回路が使 用可能であるならば $P_1 \approx 0.9346 \times 10^{-6}$ 、 $Q_1 = 0.8093 \times 10^{-6}$ 、 $\sqrt{P_2} \approx 133.7 \times 10^{-6}$ 及び $\sqrt{Q_2} \approx 124.4 \times 10^{-6}$ となり、ビーム重心位置の情報として 1 μm 程度、ビーム広がりの情報として 130 μm 程度が測定限界となり、 測定精度が改善される。

3. 特性インピーダンス

TEM 伝送路の特性インピーダンスを計算する方法は、 市販の電磁界解析ソフトウェアに電極形状等境界条件を 入力し、計算するのが一般的である。この場合、物理学 的な知見や電極形状変化に伴う特性インピーダンスの 変化傾向、支配的なパラメータなどを直感的に知ること は難しいと思われる。

そこで、無限に長い TEM 伝送路の特性インピーダン スが単位長さ当たりの静電容量に反比例する性質を利 用して、解析的手法により単位長さ当たりの静電容量を 計算し、特性インピーダンスを概算する試みを行った。 この概算を行うことで大まかな電極形状を決めること が可能となる。但し、特性インピーダンスを精度良く 50Ωに合致させるには、コンピュータによる数値計算 が不可欠である。 概算では TEM 伝送路を平行平板コンデンサと見なし て静電容量の近似計算を行った。数値計算では敢えて市 販の電磁界解析ソフトウェアを使用せず、有限差分法に より電場を計算し、ガウスの定理を応用することにより 静電容量を算出した。数値計算の精度を見積もるため に、理論的に得られる同軸管の特性インピーダンス(理 論値)を計算し、数値計算による結果と比較した。

3.1 TEM 伝送路のおさらい

抵抗を無視した場合、同軸管に代表される TEM 伝送 路は、電磁波が伝播する方向には電場及び磁場の成分が 存在せず、伝播する方向に垂直な平面内に電場及び磁場 の成分が存在する。導体表面の電荷分布と電流分布が一 致するため、電磁波の位相速度を v、単位長さ当たりの 表面電荷を Q、表面電流を I とした場合、以下の関係 を満たすことがわかる。

$$I = vQ \tag{13}$$

本発表では、真空中に置かれるストリップライン (TEM) 伝送路を考えるため、誘電率及び透磁率は周 波数に依らず ε_0 及び μ_0 となり、真空中の光速を c した 場合、

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = c \tag{14}$$

となる。

特性インピーダンス Z は導体間の電圧 V と導体表面 電流 I の比、

$$Z = \frac{V}{I} \tag{15}$$

である。単位長さ当たりの電荷量 Q と電圧 V の関係は、 単位長さ当たりの静電容量 C を用いて、

$$Q = CV \tag{16}$$

であるため、式 (15) の Z は、

$$Z = \frac{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}{C} \tag{17}$$

と表されることがわかる。

式(17)は解析的手法による概算であっても、コンピ ユータによる数値計算であっても、単位長さ当たりの静 電容量が得られれば特性インピーダンスが得られるこ とを意味する。本章では同軸管とストリップライン伝送 路に就いて、特性インピーダンス(静電容量)の計算例 を概算と数値計算の場合に分けて紹介する。

3.2 特性インピーダンス(静電容量)の概算

同軸管及びストリップライン伝送路の特性インピー ダンスを解析的手法により概算する例として、図5の ような形状を想定する。左は同軸管でありr = 0.007、 $\rho = 0.016$ である。右はストリップライン伝送路で寸法 は図4と同一である。

単位長さ当たりの静電容量は平行平板コンデンサ近 似で計算する。平行平板コンデンサ近似では電極の面 積と電極間距離 d を仮定すれば良い。電極の面積は長 手 (longitudinal) 方向の大きさが単位長 (1 m) なので、 横 (transverse) 方向の大きさ w を決めれば良い。図 5



図 5: TEM 伝送路断面寸法図 左が同軸管、右がスト リップライン伝送路

表 1: 平行平板コンデンサ近似をした場合の w 及び d

| | w | d |
|---------|-------------------------|-----------------|
| 同軸管 | $\pi(r+ ho)$ | ho - r |
| SL上面 | $\beta(A+B)/2$ | B-A |
| S L 片側面 | $(A-R) + \gamma(A+R)/2$ | $\gamma(A+R)/2$ |
| S L下面 | eta R | 2R |

で示された寸法値を使用し、*w* 及び *d* を表 1 のように 決定した。

同軸管の場合は特性インピーダンスは理論的に得られる。その値を Z_a とする。 Z_a はr及び ρ で決定され、

$$Z_a = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \log_e \frac{\rho}{r} \tag{18}$$

である。

以上を基に概算した静電容量及び特性インピーダン スと Z_a の値を表 2 に示す。ストリップライン伝送路に は左右二つの片側面があるので、片側面分の 2 倍の静 電容量が合計静電容量に加算されている。

表2からストリップライン伝送路に於いて、特性イン ピーダンスを主に決定付けている部分は側面であること がわかる。後述するが、実際にはストリップライン伝送 路の特性インピーダンスは 48.2 Ω であるので、この概 算に於ける計算精度は 20 % 程度であると考えられる。

表 2: 解析的手法による静電容量等の概算結果

| | 同軸管 | SL伝送路 | | |
|-----------------------------|--------|--------|---------|---------|
| 電極面位置 | | 上面 | 片側面 | 下面 |
| w [m] | 0.0723 | 0.0113 | 0.00348 | 0.00838 |
| d[m] | 0.009 | 0.007 | 0.00148 | 0.032 |
| $C_{part} [pF/m]$ | 71.1 | 14.3 | 20.8 | 2.3 |
| $C_{total} [pF/m]$ | 71.1 | 58.2 | | |
| $Z[\Omega]$ | 46.9 | 57.3 | | |
| $Z_a \left[\Omega \right]$ | 49.6 | | | |

3.3 特性インピーダンス(静電容量)の数値計算

コンピュータによる静電容量の数値計算では、Gauss の定理を応用した。Gaussの定理によれば適当な閉曲面 を作り、その面に直交する電場成分を積分した量は閉曲 面内側の電荷量に等しくなる、すなわち、

$$\frac{Q}{\varepsilon} = \int_{S} \boldsymbol{E} \cdot \boldsymbol{n} dS \tag{19}$$

である。TEM 伝送路で積分を行う場合、電磁波の伝播 方向には電場成分は存在しないので、電磁波の伝播方向 に垂直な面の積分は無視出来る。

式(19)から適当な閉曲面上での電場を知ることが必要であることがわかる。電場の計算方法には有限要素法や境界要素法など多々あるが、本発表では一番簡易な 有限差分法を採用した。プログラミングは二次元で行い、図5に示す断面形状に図6に示すような二次元正方 形メッシュを切って実行した。メッシュの交点がノード であり、各ノードに於ける電位及び電場が計算される。 ノード間隔は50 µm である。各ノードに於いては電位



図 6: 二次元有限差分法によるメッシュとノード

の逐次代入が行われ電位値が収束していく。但し、中心 電極内部に存在するノードは常に100V、外導体内部に 存在するノードは常に0Vに固定されている。図6中、 I及びJは空間位置の添え字、Kはイタレーションナ ンバーである。逐次代入のアルゴリズムは式(20)に示 す通りである。

$$\Phi_{I,J,K+1} = \frac{\Phi_{I-1,J,K} + \Phi_{I+1,J,K} + \Phi_{I,J-1,K} + \Phi_{I,J+1,K}}{4}$$
(20)

以上の計算手法により行った電位計算の結果を、図7 (同軸管)及び図8(ストリップライン伝送路)に示す。 図中の白色の部分が中心導体で100Vに固定した部分 であり、黒色の部分が外導体で0Vに固定した部分で ある。計算が行われた部分は白色と黒色の間の空間で、 電位は赤色(100-80V)、橙色(80-60V)、黄色(60-40V)、緑色(40-20V)及び青色(20-0V)で示され ている。

各ノードに於ける電場は二次元空間内で微分を行う ことによって得られる。電場積分を行うために、図9の 破線で示すような閉曲面を仮定し、積分を行った。表3 に数値計算の結果を示す。

表3に於いて数値計算された同軸管の特性インピー ダンスZ(49.0 Ω)を理論値Z_a(49.6 Ω 、表2)と比べ ると、1%程度Z_aが大きいことがわかる。故にこの数 値計算に於ける計算誤差は1%程度と見積もられるこ とがわかった。



図 7: 有限差分法による同軸管の電位計算



図 8: 有限差分法によるストリップライン伝送路の電位 計算

ストリップライン伝送路の特性インピーダンスは 48.2 Ω と数値計算された。ストリップライン長は検波 RF 波長 105 mm (2,856 MHz) の 1/4 波長程度なので 1.8 Ω のインピーダンスのずれは検出性能に影響しない と思われる。

4. まとめ

二次モーメント測定用の六電極円形断面 BPM を設計 した。BPM の開口は ϕ 32 mm で、電極占有角は 30° で



図 9: 電場積分を行うための経路

表 3: 静電容量等の数値計算結果

| | 同軸管 | S L 伝送路 |
|-------------------------|------|---------|
| 電場積分 [V·m/m] | 769 | 782 |
| Q [nC/m] | 6.81 | 6.92 |
| 電極間電圧 [V] | 100 | 100 |
| $C \left[pF/m \right]$ | 68.1 | 69.2 |
| $Z[\Omega]$ | 49.0 | 48.2 |

ある。現存の BPM 信号処理回路を使用した場合、測定 精度はビーム重心位置の情報として 10 μm 程度、ビー ム広がりの情報として 400 μm 程度である。

ストリップライン伝送路の特性インピーダンスを50Ω 程度とするために、単位長さ当たりの静電容量を計算 し、特性インピーダンスを算出する手法を確立した。単 位長さ当たりの静電容量を解析的手法により得るには、 平行平板コンデンサ近似を行い概算する。単位長さ当 たりの静電容量を精度良く計算するにはコンピュータ による数値計算が不可欠である。本設計では二次元有 限差分法により電位・電場を計算し、Gaussの定理を応 用して単位長さ当たりの静電容量を精度良く計算した。 計算されたストリップライン伝送路の特性インピーダン スは48.2Ωで、数値計算の精度は1%程度と見積もら れる。

参考文献

- [1] T. Suwada, et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 6, 032801 (2003).
- [2] A. Chapman-Hatchett, et al., "A Magnetic Quadrupole Pick-Up for The CERN PS", Proc. 18th Particle Accel. Conf. New York USA, 1999, pp. 2223-2225.
- [3] R. H. Miller, et al., "Nonintercepting Emittance Monitor", Proc. 12th Int. Conf. High-Energy Accel. (HEAC'83) Fermilab USA, 1983, pp. 603-605.
- [4] K. Yanagida, et al., "A BPM System for The SPring-8 Linac", Proc. 20th Int. Linear Accel. Conf. Monterey USA, 2000, pp. 190-192.